

NPN-SWITCHING SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/251

DEVICES

2N2218	2N2219
2N2218A	2N2219A
2N2218AL	2N2219AL

LEVELS

JAN
JANTX
JANTXV
JANS *

* Also available in Radiation Hardened versions. See datasheet for JANSR2N2218 & JANSR2N2219

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_C = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	2N2218 2N2219	2N221A; L 2N2219A; L	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	30	50	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	60	75	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5.0	6.0	Vdc
Collector Current	I_C	800		mA
Total Power Dissipation @ $T_A = +25^\circ\text{C}$ @ $T_C = +25^\circ\text{C}$	P_T	0.8 3.0		W W
Operating & Storage Junction Temp. Range	T_{op}, T_{stg}	-55 to +200		$^\circ\text{C}$

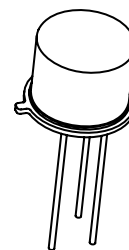
THERMAL CHARACTERISTICS

Parameters / Test Conditions	Symbol	Value	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	59	$^\circ\text{C/W}$

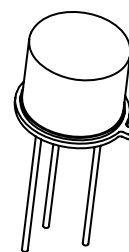
Note: (1) Derate linearly 4.6mW/ $^\circ\text{C}$ above $T_A > +25^\circ\text{C}$
(2) Derate linearly 17.0mW/ $^\circ\text{C}$ above $T_C > +25^\circ\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = +25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
OFF CHARACTERISTICS				
Collector-Emitter Breakdown Voltage $I_E = 10\text{mA}$ 2N2218; 2N2219 2N2218A; 2N2219A / AL	$V_{(BR)CEO}$	30 50		Vdc
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 5.0\text{Vdc}$ $V_{EB} = 6.0\text{Vdc}$ $V_{EB} = 4.0\text{Vdc}$ 2N2218; 2N2219 2N2218A; 2N2219A / AL All Types	I_{EBO}		10 10 10	μAdc ηAdc
Collector-Base Cutoff Current $V_{CE} = 30\text{Vdc}$ $V_{CE} = 50\text{Vdc}$ 2N2218; 2N2219 2N2218A; 2N2219A / AL	I_{CES}		10 10	ηAdc



TO-39 (TO-205AD)
2N2218, 2N2218A
2N2219, 2N2219A



TO-5
2N2218AL
2N2219AL

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = +25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted) (Con't)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit		
Collector-Base Cutoff Current V _{CB} = 50Vdc V _{CB} = 60Vdc V _{CB} = 60Vdc V _{CB} = 75Vdc	I _{CBO}		10 10 10 10	ηAdc μAdc ηAdc μAdc		
ON CHARACTERTICS (3)						
Forward-Current Transfer Ratio I _C = 0.1mAdc, V _{CE} = 10Vdc I _C = 1.0mAdc, V _{CE} = 10Vdc I _C = 10mAdc, V _{CE} = 10Vdc I _C = 150mAdc, V _{CE} = 10Vdc I _C = 500mAdc, V _{CE} = 10Vdc		h _{FE}	20 35 30 50 25 50 35 75 35 75 40 100 40 100 20 30	150 325 150 325 120 300		
2N2218 2N2219 2N2218A; 2N2218AL 2N2219A; 2N2219AL						
2N2218 2N2219 2N2218A; 2N2218AL 2N2219A; 2N2219AL						
2N2218; A; AL 2N2219; A; AL						
2N2218; A; AL 2N2219; A; AL						
2N2218; 2N2219 2N2218A; 2N2219A / AL	V _{CE(sat)}			0.4 0.3	Vdc	
2N2218; 2N2219 2N2218A; 2N2219A / AL				1.6 1.0		
Base-Emitter Saturation Voltage I _C = 150mAdc, I _B = 15mAdc I _C = 500mAdc, I _B = 50mAdc	V _{BE(sat)}		0.6 0.6	1.3 1.2	Vdc	
2N2218; 2N2219 2N2218A; 2N2219A / AL						
2N2218; 2N2219 2N2218A; 2N2219A / AL						2.6 2.0

DYNAMIC CHARACTERISTICS

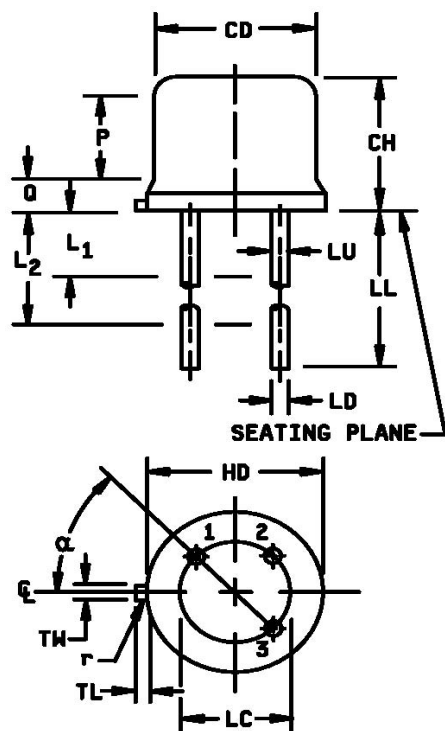
Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Magnitude of Small-Signal Forward Current Transfer Ratio $I_C = 20\text{mA}$, $V_{CE} = 20\text{V}$, $f = 100\text{MHz}$	$ h_{fe} $	2.5	12	
Small-Signal Forward Current Transfer Ratio $I_C = 1.0\text{mA}$, $V_{CE} = 10\text{V}$, $f = 1.0\text{kHz}$ 2N2218 2N2219 2N2218A, AL 2N2219A, AL	h_{fe}	25 50 35 75		
Output Capacitance $V_{CB} = 10\text{V}$, $I_E = 0$, $100\text{kHz} \leq f \leq 1.0\text{MHz}$	C_{obo}		8.0	pF
Input Capacitance $V_{EB} = 0.5\text{V}$, $I_C = 0$, $100\text{kHz} \leq f \leq 1.0\text{MHz}$	C_{ibo}		25	pF

SWITCHING CHARACTERISTICS

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
$V_{CC} = 30\text{V}$; $I_C = 150\text{mA}$; $I_{B1} = 15\text{mA}$				
Turn-On Time (See Figure 3 of MIL-PRF-19500/251) 2N2218, 2N2219 2N2218A, 2N2219A / AL	t_{on}		40 35	ns
Turn-Off Time (See Figure 4 of MIL-PRF-19500/251) 2N2218, 2N2219 2N2218A, 2N2219A / AL	t_{off}		250 300	ns

(3) Pulse Test: Pulse Width = 300μs, Duty Cycle ≤ 2.0%.

PACKAGE DIMENSIONS



	Dimensions				
Symbol	Inches		Millimeters		Notes
	Min	Max	Min	Max	
CD	.305	.335	7.75	8.51	
CH	.240	.260	6.10	6.60	
HD	.335	.370	8.51	9.40	
LC	.200 TP		5.08 TP		7
LD	.016	.019	0.41	0.48	8, 9
LL	See note 14				
LU	.016	.019	0.41	0.48	8, 9
L ₁		.050		1.27	8, 9
L ₂	.250		6.35		8, 9
P	.100		2.54		7
Q		.030		0.76	5
TL	.029	.045	0.74	1.14	3, 4
TW	.028	.034	0.71	0.86	3
r		.010		0.25	10
α	45° TP		45° TP		7

NOTES:

- Dimensions are in inches.
- Millimeters are given for general information only.
- Beyond r (radius) maximum, TW shall be held for a minimum length of .011 (0.28 mm).
- Dimension TL measured from maximum HD.
- Body contour optional within zone defined by HD, CD, and Q.
- CD shall not vary more than .010 inch (0.25 mm) in zone P. This zone is controlled for automatic handling.
- Leads at gauge plane .054 +.001 -.000 inch (1.37 +0.03 -0.00 mm) below seating plane shall be within .007 inch (0.18 mm) radius of true position (TP) at maximum material condition (MMC) relative to tab at MMC.
- Dimension LU applies between L₁ and L₂. Dimension LD applies between L₂ and LL minimum. Diameter is uncontrolled in L₁ and beyond LL minimum.
- All three leads.
- The collector shall be internally connected to the case.
- Dimension r (radius) applies to both inside corners of tab.
- In accordance with ASME Y14.5M, diameters are equivalent to øx symbology.
- Lead 1 = emitter, lead 2 = base, lead 3 = collector.
- For L suffix devices (TO-5), dimension LL = 1.5 inches (38.10 mm) min. and 1.75 inches (44.45 mm) max. For non-L suffix types (TO-39), dimension LL = .5 inch (12.70 mm) min. and .750 inch (19.05 mm) max.

FIGURE 1. Physical dimensions (similar to TO-39, TO-5).



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.